

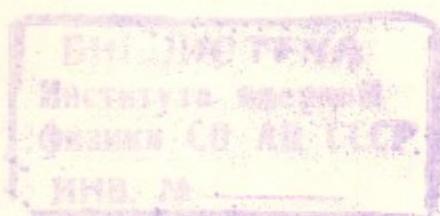
B. 84

ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ
СО АН СССР

69

Т.А.Всеволожская, В.А.Киселев,
В.И.Купчик, Г.И.Сильвестров

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЯ
В ИМПУЛЬСНЫХ ОДНОВИТКОВЫХ
МАГНИТАХ С ШИХТОВАННЫМ
МАГНИТОПРОВОДОМ



ПРЕПРИНТ ИЯФ 79-89

Новосибирск

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЯ В ИМПУЛЬСНЫХ ОДНОВИТКОВЫХ
МАГНИТАХ С НИХТОВАННЫМ МАГНИТОПРОВОДОМ

Т.А.Всеволожская, В.А.Киселев, В.И.Купчик
Г.И.Сильвестров

А Н Н О Т А Ц И Я

Приведены результаты расчетного и экспериментального ис-
следования формирования поля в импульсных одновитковых диполь-
ных магнитах с прямоугольной апертурой.

Методом конформных отображений с учетом конечной толщины
скин-слоя во втором приближении решения приведен аналитический
расчет влияния изоляционных зазоров между токовыми шинами и
магнитопроводом на топографию поля в апертуре. Рассмотрены ме-
тоды компенсации искажающего действия изоляционного зазора пу-
тем пиммирования токоведущих шин, влияние на возмущение поля
перекосов шин и насыщения железа.

На комплексах встречных пучков Института ядерной физики СО АН СССР при разработке электронных синхротронов и импульсных элементов электронно оптических каналов нашли широкое применение конструкции одновитковых импульсных магнитов, в которых токовые шины активно участвуют в формировании магнитного поля в апертуре [1,2]. Топография магнитного поля в таких системах определяется формами полюсов шихтованного магнитопровода и токовых поверхностей шин. Принципиальным фактором исказяющим топографию поля даже в случае идеальной геометрии и бесконечно большой магнитной проницаемости железа, является наличие изоляционных зазоров между шинами и полюсами (рис. Ia), влияние которых усиливается в случае конечной толщины скин-слоя из-за увеличения эффективной ширины зазора. В реальных конструкциях дополнительными исказяющими факторами являются: неточность взаимного расположения шин и полюсов, неоднородность и конечная магнитная проницаемость железа, насыщение его при повышенных индукциях и т.д.

Ниже приводятся результаты расчетного и экспериментального исследования формирования поля в подобных магнитных системах, которые были предприняты в связи с выбором конструктивного варианта магнито-оптических элементов каналов для транспортировки пучков высоких энергий в накопитель ВЭП-4.

I. ИСКАЗАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ЗАЗОРОВ

Для оценки влияния зазоров на точность формирования поля в апертуре был проведен расчет методом конформных отображений для прямоугольной геометрии с учетом конечной толщины скин-слоя в решении второго приближения, определяемом при толщине скин-слоя много меньшей высоты шин [3] граничным условием на их поверхности $H_n^{(2)} = \frac{j}{K} \frac{\partial H_t^{(1)}}{\partial t}$. Здесь j и t обозначают нормальное и тангенциальное направления к поверхности, j — временную минимую единицу в отличие от пространственной — i , $K = \frac{1+j}{\delta}$ — волновое число, δ — толщина скинслоя.

Решение первого приближения $H^{(1)}$, соответствующее бесконечно тонкому скин-слою, находится отображением области апертуры, примыкающей к одной из шин, в предложении бесконечной уда-

ленности второй шины ($x_0 \gg y_0$) на полуполосу в плоскости W (рис. Iб) с полем $H^{(1)}(W) = iH_0$, так что потенциал первого приближения есть $Z^{(1)} = -iH_0 W$. Потенциал второго приближения $Z^{(2)}$ с учетом приведенного выше граничного условия на поле $H^{(2)}$ в плоскости z имеет вид:

$$Z^{(2)} = -\frac{i\Delta H_0}{K\pi} \sqrt{\frac{\xi-1}{\xi-1+\frac{\Delta^2}{y_0^2}}} \cdot \left\{ \pi - 2 \operatorname{Arth} \frac{\Delta}{y_0} \sqrt{\frac{\xi}{\xi-1+\frac{\Delta^2}{y_0^2}}} \right\},$$

где ξ для правой шины связано с z соотношением:

$$z - x_0 = -\frac{2y_0}{\pi} \left\{ \operatorname{Arth} \frac{\Delta}{y_0} \sqrt{\frac{\xi}{\xi-1+(\frac{\Delta}{y_0})^2}} - \frac{\Delta}{y_0} \operatorname{Arth} \frac{\Delta}{y_0} \sqrt{\frac{\xi}{\xi-1+(\frac{\Delta}{y_0})^2}} \right\} \quad (I)$$

$$\text{а с } W - \xi = \sin^2 \frac{\pi(z-x_0)}{2iy_0}.$$

Выражение для поля в плоскости z , $H^*(z) = \frac{d(Z^{(1)} + Z^{(2)})}{dz}$, где (*) означает комплексное сопряжение по пространственной мнимой единице, учитываящее влияние зазоров от правой шины имеет вид:

$$H^*(z) = -iH_0 \cdot \sqrt{\frac{\xi-1}{\xi-1+(\frac{\Delta}{y_0})^2}} \left\{ 1 - \frac{j\Delta}{Ky_0^2} \left\{ \frac{1}{\xi-1+(\frac{\Delta}{y_0})^2} + \frac{\Delta}{y_0} \sqrt{\frac{\xi}{(\xi-1+\frac{\Delta^2}{y_0^2})^3}} \left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{Arth} \frac{\Delta}{y_0} \sqrt{\frac{\xi}{\xi-1+\frac{\Delta^2}{y_0^2}}} \right) \right\} \right\}, \quad (2)$$

т.е. с точностью до членов второго порядка малости по $\frac{\Delta}{y_0}$

$$H^*(z) \cong -iH_0 \left\{ 1 + \left\{ \frac{\Delta^2}{y_0^2} + \frac{2j\Delta}{Ky_0^2} \left[1 - \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\Delta}{y_0} \operatorname{th} \frac{\pi(z-x_0)}{2y_0} \right] \right\} \frac{1}{\operatorname{ch} \frac{\pi(z-x_0)}{2y_0} + 1} \right\} \quad (3)$$

Искажения поля от зазоров левой шины получаем из выражений (I), (2), (3) при изменении знака перед реальными частями z и H , так что $H_{лев.}(z) = -H_{прав.}^*(-z^*)$

Точный учет конечного размера апертуры по X и влияния зазоров сразу от обеих шин существенно усложняет расчет, однако при $x_0 \gg y_0$ достаточно высокую точность в определении искажений поля ($\sim e^{-2\pi y_0/\lambda_0}$) обеспечивает приближенный учет путем

подстановки в (2) и (3) вместо постоянного множителя $-iH_0$, представляющего собой асимптотическое значение $H^*(z)$ при $\operatorname{Re}(z-x_0) \gg y_0$, выражения для поля $H^{(2)}$, искаженного зазорами противоположной шины, а именно

$$H_{лев.+прав}^* \cong \frac{H_{прав.}^*(z) \cdot H_{лев.}^*(z)}{-iH_0} = -i \frac{H_{прав.}^*(z) \cdot H_{прав.}^*(-z^*)}{H_0}, \quad (4)$$

т.е. с точностью до членов порядка $(\frac{\Delta}{y_0})^2$

$$H_{лев.+прав}^* \cong -iH_0 \left\{ 1 + \frac{\Delta}{y_0} \left(\frac{\Delta}{y_0} + \frac{2\pi}{y_0} \right) \left[\frac{1}{\operatorname{ch} \frac{\pi}{y_0} (z-x_0) + 1} + \frac{1}{\operatorname{ch} \frac{\pi}{y_0} (z+x_0) + 1} \right] \right\} \quad (5)$$

$$+ j \frac{\pi \Delta^2}{Ky_0^3} \left[\frac{\operatorname{th} \frac{\pi}{2y_0} (z+x_0)}{\operatorname{ch} \frac{\pi}{2y_0} (z+x_0) + 1} - \frac{\operatorname{th} \frac{\pi}{2y_0} (z-x_0)}{\operatorname{ch} \frac{\pi}{2y_0} (z-x_0) + 1} \right].$$

Коэффициент квадратичной нелинейности a_2 , определяемый как $a_n = \frac{x_0^n}{n!} \cdot \frac{\partial^n H_0}{\partial X^n}|_{X=0}$, с указанной выше точностью описывается выражением:

$$a_2 \cong \frac{\pi^2 x_0^2}{y_0^4} \left[\Delta^2 + 2j\Delta \left(1 + \frac{\pi\Delta}{2y_0} \right) \right] \frac{\operatorname{ch} \frac{\pi x_0}{y_0} - 2}{\left(\operatorname{ch} \frac{\pi x_0}{y_0} + 1 \right)^2} \quad (6)$$

Комплексность выражений для H и a_2 по временной мнимой единице j означает сдвиг поля по фазе относительно питающего тока.

При синусоидальной форме импульса тока множитель $\frac{2j}{Ky_0} = \frac{\sqrt{2}\delta}{y_0} e^{j\frac{\pi}{4}}$ есть $\frac{\sqrt{2}\delta}{y_0} \frac{\sin(\omega t - \frac{\pi}{4})}{\sin \omega t}$, а выражение в квадратных скобках в формуле (6), которое можно рассматривать как определение квадрата эффективной толщины зазора $\Delta_{эфф.}$, принимает вид:

$$\Delta_{эфф.}^2 = \Delta^2 + \sqrt{2} \cdot \frac{\sin(\omega t - \frac{\pi}{4})}{\sin \omega t} \quad \text{ЧТО}$$

при $\omega t = \frac{\pi}{2}$ переходит в

$$\Delta_{эфф.}^2 = \Delta^2 (1 + G) \quad (7)$$

Экспериментальное измерение полей производилось на модели, показанной на рис. Iа, с вертикальной апертурой 40 мм и радиальной 60 мм. Модель запитывалась униполярными синусоидальными импульсами тока, с длительностью τ по основанию, варьируемой в пределах 0.1-10 мсек. Изменяя τ и величину изоляционного зазора можно было в широких пределах варьировать отношение скин-слоя δ и ширины зазора Δ .

Сравнение искажений поля, вычисленных по (4) с H_y , определяемым по (2), с результатами измерений на модели в фазе $\omega t = \frac{\pi}{2}$ синусоидального импульса тока, приводятся на рисунках 2 (а, б, в, г). Наблюдается хорошее согласие расчетных и экспериментальных данных для медианной плоскости ($y = 0$) и несколько худшее для $y = 0.6 y_o$, где y_o полувысота шины. Значения коэффициентов квадратичной нелинейности, полученных при интерполяции экспериментальной зависимости поля H_y от x в медианной плоскости трехчленом $H_y(x) = a_0 + a_2^{(эксп)} \frac{x^2}{x_0^2} + a_4^{(эксп)} \frac{x^4}{x_0^4}$, совпадает (таблица I) со значениями a_2 , вычисленными по выражению (6), в пределах точности коэффициентов $a_2^{(эксп)}$, обусловленной точностью измерений значения поля ($\sim \pm 2 \cdot 10^{-4}$) и координат измерительных датчиков ($\sim 1 \cdot 10^{-2}$ см).

Таблица I.

Δ/y_o	δ/y_o	a_2	$a_2^{(эксп)}$
0.05	0.11	0.0032	0.0041 ± 0.0011
0.05	0.27	0.0063	0.0055 ± 0.0011
0.1	0.1	0.0080	0.0091 ± 0.0009
0.1	0.2	0.0123	0.0114 ± 0.0009

2. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЯ ШИММИРОВАНИЕМ ТОКОВЫХ ШИН

Возможность компенсации искажающего действия изоляционных зазоров и насыщения железа, влияние перекосов шин и т.п. исследовались экспериментально на модели в геометрии рис. Iа. Измере-

ния производились с помощью матрицы из 32 индукционных датчиков расположенных в апертуре магнита в три горизонтальных ряда [4]. Результаты измерений представлялись в виде коэффициентов разложения поля по степеням координат x и z , нормированных на радиальную полуаперттуру магнита $x_o = 3 \text{ см}$ ^{*)}

$$H_z = C_1 + C_2 x + C_3 z + C_4 \left(\frac{x^2}{2} - \frac{z^2}{2} \right) + C_5 xz + C_6 \left(\frac{x^3}{6} - \frac{xz^2}{2} \right) + \dots$$

и т.д. до пятой степени включительно, а также в виде рисунков, иллюстрирующих топографию поля в апертуре путем выделения границ областей с заданной степенью однородности z - и x -компонент поля, построенных по этим коэффициентам.

Рис. 3а относится к случаю плоских шин при изоляционном зазоре $\Delta = 1 \text{ мм}$, $\delta = 7 \text{ мм}$ ($\tau = 6 \text{ мсек}$) и $H = 10 \text{ кЭ}$. Здесь белой оставлена область с относительной однородностью поля $|\frac{\Delta H}{H_o}| \leq 0.1\%$, а знаками обозначены области со значениями $\frac{\Delta H}{H_o}$ в пределах $0 - +0.1\% < \frac{\Delta H}{H_o} \leq 0.2\%$, $Q - -0.1\% > \frac{\Delta H}{H_o} \geq -0.2\%$; $K - 0.2\% < |\frac{\Delta H}{H_o}| \leq 0.3\%$; $B - 0.3\% < |\frac{\Delta H}{H_o}| \leq 0.5\%$ и т.д.

Выбранный способ представления результатов измерения топографии поля обладает хорошей наглядностью и позволяет делать количественные и качественные выводы о характере нелинейностей и способах их уменьшения.

Для расширения области однородности поля компенсация искажающего действия зазоров может быть осуществлена увеличением около них плотности тока путем создания на шине специальных выступов (швимм), геометрия которых (рис. 4а, б) выбирается для конкретных величин зазора и скин слоя в заданной фазе, например, в максимуме синусоиды поля. На рис. 3б приведена топография поля, полученная в результате выбора оптимальной геометрии швиммирования ($a_{\text{ши}} = 0.4 \text{ мм}$, $b_{\text{ши}} = 10 \text{ мм}$ на рис. 4а) для $\Delta = 1 \text{ мм}$, $\delta = 7 \text{ мм}$ ($\tau = 6 \text{ мсек}$). Сравнение с рис. 3а показывает, что область поля с $|\frac{\Delta H}{H}| \leq 0.1\%$ увеличилась с 50% до 87% геометрической апертуры, а характерные для дипольного магнита коэффициенты разложения поля C_4 и C_8 изменились от $C_4 = 6.6 \cdot 10^{-3}$ и $C_8 = 141 \cdot 10^{-3}$ до $C_4 = -0.26 \cdot 10^{-3}$ и $C_8 = -46 \cdot 10^{-3}$.

^{*)} Коэффициент C_4 совпадает с коэффициентом a_2 в обозначениях пункта I, координата z — с координатой y .

Топография поля остается практически неизменной при вариации длительности импульса в пределах от 4 до 8 мсек. Галльнейшее увеличение области однородности достигается введением шимм более сложного профиля (рис.4б), однако простота изготавления одноступенчатых шимм и не жесткие допуски ($a = 0,4 \pm 0,1$ мм, $b = 10 \pm 1$ мм) делают их предпочтительными для практического использования.

Введение шимм с размерами a и b , большими оптимальных для данной величины скин-слоя, приводит к появлению нелинейностей, которые по виду соответствуют нелинейностям, возникающим при частичном насыщении железа, но имеющим противоположный знак. Это позволило сделать предположение о возможности частичной компенсации шиммированием эффектов насыщения железа. На рис.5а приведено распределение поля при размерах шимм $a = 0,4$ мм, $b = 10$ мм и $\delta = 2$ мм ($\tau = 0,6$ мсек) при поле $H = 5$ кэрст, на рис.7б — распределение поля в нешимирированном магните при $H = 18,5$ кэрст. Соответствующие этим распределениям нелинейности характеризуются величинами: $C_4 = -20 \cdot 10^{-3}$, $C_3 = 360 \cdot 10^{-3}$ для рис.5а и $C_4 = 22 \cdot 10^{-3}$, $C_3 = 130 \cdot 10^{-3}$ — для рис.7б). Увеличение поля в геометрии рис.5а до $H = 18,5$ кэрст приводит к частичной компенсации и уменьшению нелинейностей до величин $C_4 = 6 \cdot 10^{-3}$, $C_3 = -142 \cdot 10^{-3}$ и увеличению "белой области" с 23% до 63% от всей апертуры магнита (рис.5б).

Могут быть использованы и другие способы коррекции искахающего действия зазоров и частичного насыщения железа. В частности, комбинация шиммирования одновременно и токовой шиной и полюса (рис.4в) позволяет улучшить топографию поля в разных фазах синусоидального импульса тока, поскольку на начальных стадиях диффузии скин-слоя большее влияние оказывает шимм на токовойшине, а к максимуму тока начинаетказываться шиммирование полюса. Эта же цель может быть достигнута созданием одновременно выступа на формирующей поверхности шины и выборки внутри шины на глубине $\sim \delta$ (рис.4г).

3. ВЛИЯНИЕ ПЕРЕКОСОВ ШИН

Допуски на взаимную параллельность шин и перпендикулярность их полюсам в большой степени определяется геометрией магнита — отношением его радиальной X , и вертикальной Y апертуры — и при $\frac{X_0}{Y_0} \sim 1$ существенно зависят от относительной величины скин-слоя. Для бесконечно малого скин-слоя перекос шин приводит к вертикальному градиенту поля, пропорциональному относительному изменению расстояния между шинами, для конечной величины δ эта зависимость усложняется.

Результаты изменения топографии поля в геометрии рис.1, вызванного умышленным перекосом одной из шин путем смещения её у верхнего полюса на величину $\Delta X = 0,5$ мм при $\delta = 7$ мм и $\delta = 1$ мм, приведены на рис.6а и 6в соответственно. В расположении поля H_z появились дополнительные члены C_2 и C_5 , в обоих случаях давшие постоянный градиент в вертикальном направлении $G = 0,6 \cdot 10^{-3} H_0$ и линейные от z добавки $\Delta G = -0,3 \cdot 10^{-3} H_0 z$ в первом и $\Delta G = -2,5 \cdot 10^{-3} H_0 z$ во втором случае.

4. ВЛИЯНИЕ НАСЫЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗА НА ТОПОГРАФИЮ И ЭНЕРГОЕМКОСТЬ МАГНИТА

Влияние насыщения полюсов всегда зависит от конкретной геометрии магнита — соотношения вертикального и горизонтального размеров апертуры, формы полюсов, расположения и размеров обмоток возбуждения.

В импульсных одновитковых системах, в которых практически отсутствуют поля рассеяния за исключением малой доли потока, идущей по скин-слоям наиболее выгодно работать на повышенных индукциях с частичным насыщением железа при апертурах близких к квадратным, когда скиновые поверхности играют существенную роль в формировании поля.

В последующей нами геометрии при апертуре $a_x = \pm 30$ мм, $a_2 = \pm 20$ мм, измерения полей производились при индукциях в железе до 25 кГс.

На рис.7 приведены картины топографии поля для плоских шин при индукциях 15 кГс (а), 18.5 кГс (б), 22 кГс (в), 25 кГс (г). На рис.8 (кривая 1) показано изменение коэффициента квадратичной нелинейности C_4 в зависимости от B . При выбранной нами толщине шихтовки магнитопровода, выполненного из стали 0.8 КП с толщиной пластин $d = 2$ мм, истинная индукция из-за коэффициента заполнения, равного ~ 0.95 на 5% выше.

Выбор материала магнитопровода и толщины шихтовки, определяющей коэффициент заполнения, становятся существенными при оценке энергоемкости магнита, работающего в режиме насыщения. На рис.8 (кривая 2) показано изменение эффективности магнита – отношения H/J (H_0 – поле в центре апертуры, J – ток возбуждения), нормированной на H_0/J при $B = 5$ кГс, в зависимости от B , для стали 0.8 КП с $d = 2$ мм (кривая 2) и стали Э-4 с $d = 0.5$ (кривая 3) при одинаковых изоляционных зазорах между пластинами ~ 0.05 мм.

Изменение в широких пределах толщины шихтовки на модели позволило измерить характер зависимости коэффициента C_4 от d/δ_{cu} , где d – толщина пластин, а δ_{cu} – скин-слой в меди (рис.8 кривая 4). Из этой кривой видна возможность использования в импульсных магнитах с редкой частотой посылок импульсов (< 1 Гц), когда можно пренебречь нагревом железа за счет вихревых токов, толщин шихтовки вплоть до значений $d/\delta_{cu} \sim 0.5$.

Проведенные исследования позволили выбрать основные параметры больших поворотных магнитов с радиусом 4 м, являющихся элементами сложной и протяженной системы транспортировки пучков электронов и позитронов с энергией до 2.5 ГэВ для перепуска их из бустерного накопителя ВЭПП-3 в накопитель ВЭПП-4 [5,6].

Л и т е р а т у р а

- Л.Л.Данилов, Э.М.Трахтенберг, Г.И.Сильвестров. Труды I-го Всесоюзного совещания по ускорителям. Москва, 1968. ВНИТИ 1970 г. т.1, стр.287.
- Л.Л.Данилов, А.А.Лившиц, Э.М.Трахтенберг, Г.И.Сильвестров. Электромагнит синхротрона. Авторское свидетельство № 212394, 1967 г.
- Г.Каден. Электромагнитные экраны. Госэнергоиздат, М-Л, 1957 г.
- В.Т.Волохов, В.В.Каргальцев, В.А.Киселев, В.И.Купчик, Г.И.Сильвестров. Препринт ИЯФ, 76-90, Новосибирск, 1971.
- Т.А.Всеволожская, Г.И.Сильвестров. Труды III Всесоюзного совещания по ускорителям, Москва, 1972. "Наука" 1973. т.П, стр.122.
- В.А.Анашин и др. Труды У Всесоюзного совещания по ускорителям. Дубна, 1976. М., "Наука" 1977 г. т.П, стр.123.

^{*}) Введение в качестве параметра скин-слоя в меди удобно, так как скин-слой в железе зависит от индукции $\delta = \delta(B)$.

ПОДПИСИ К РИСУНКАМ

Рис.1.

- а) поперечное сечение модели
- б) отображение области апертуры на полуполосу

Рис.2.

Сравнение искажений поля, вычисленных по (4) и (2)
с результатами измерений на модели в фазе $\omega t = \pi/2$.

- а) $\Delta = 0.05$, $\delta = 0.11$
- б) $\Delta = 0.05$, $\delta = 0.27$
- в) $\Delta = 0.1$, $\delta = 0.1$
- г) $\Delta = 0.1$, $\delta = 0.2$

Рис.3.

Компенсация влияния изоляционного зазора на топографию
магнитного поля

- а) плоская шина
- б) шиммированная шина

Рис.4.

Способы шиммирования магнитопровода и токонесущих шин

- а) одноступенчатое шиммирование шины
- б) двухступенчатое шиммирование шины
- в) одновременное шиммирование шины и магнитопровода
- г) шиммирование магнитопровода

Рис.5.

Влияние шиммирования на топографию поля при насыщении
магнитопровода

- а) $B = 5$ кГс
- б) $B = 18,5$ кГс

Рис.6.

Влияние перекосов шин на топографию поля при различной
глубине скрин-слоя

- а) $\delta = 7$ мм
- б) $\delta = 1$ мм

Рис.7.

Влияние насыщения магнитопровода на топографию поля
для плоских шин

- а) $B = 15$ кГс
- б) $B = 18,5$ кГс
- в) $B = 22$ кГс
- г) $B = 25$ кГс

Рис.8.

- 1 - Зависимость коэффициента квадратичной нелинейности C_4 от величины индукции для стали 0.8 КП
- 2 - Зависимость эффективности магнита от индукции для стали 0.8 КП, толщине пластин $d = 2$ мм
- 3 - То же, что и 2), для стали Э-4, $d = 0,5$ мм
- 4 - Зависимость коэффициента квадратичной нелинейности от толщины пластин магнитопровода.

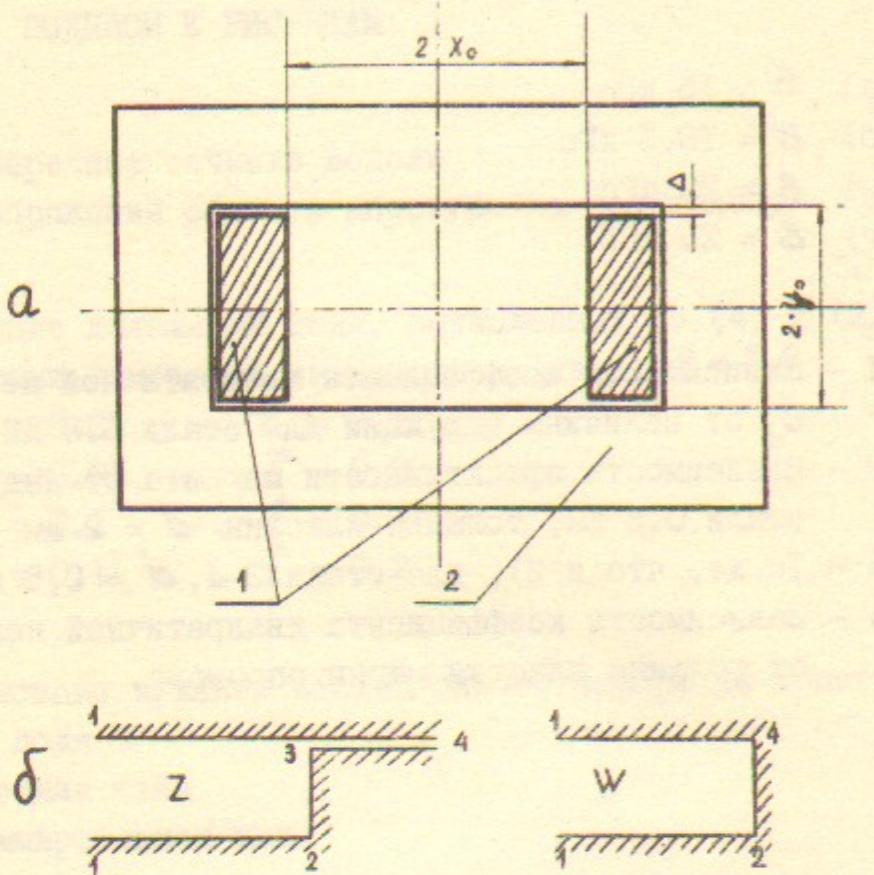


РИС. 1.

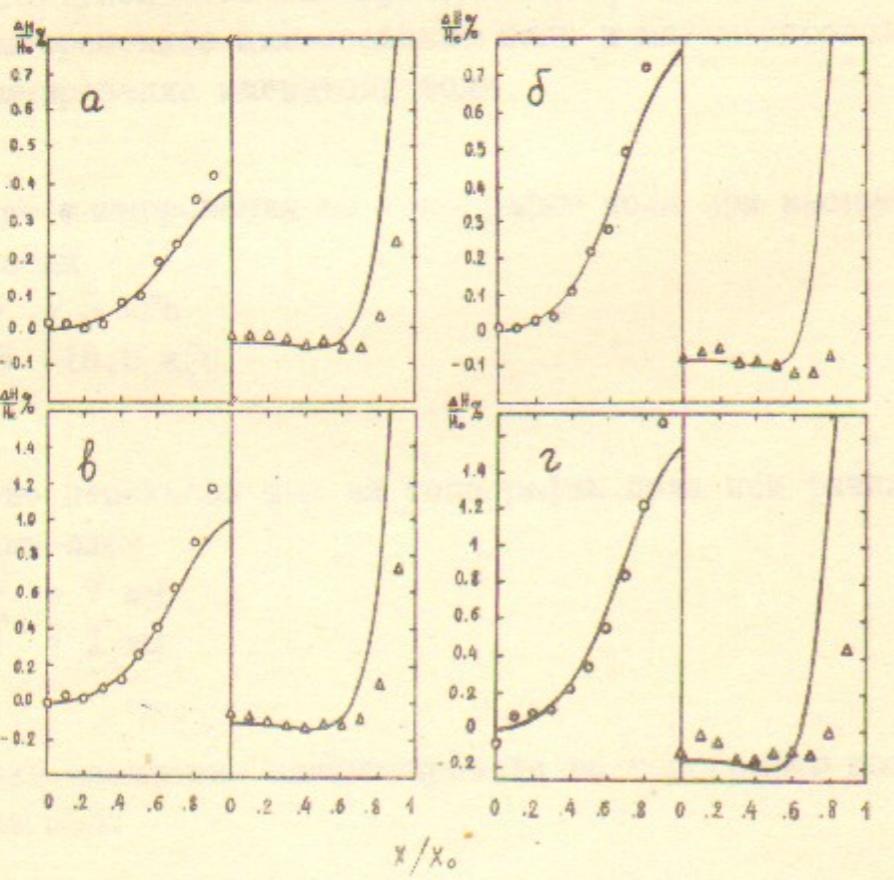
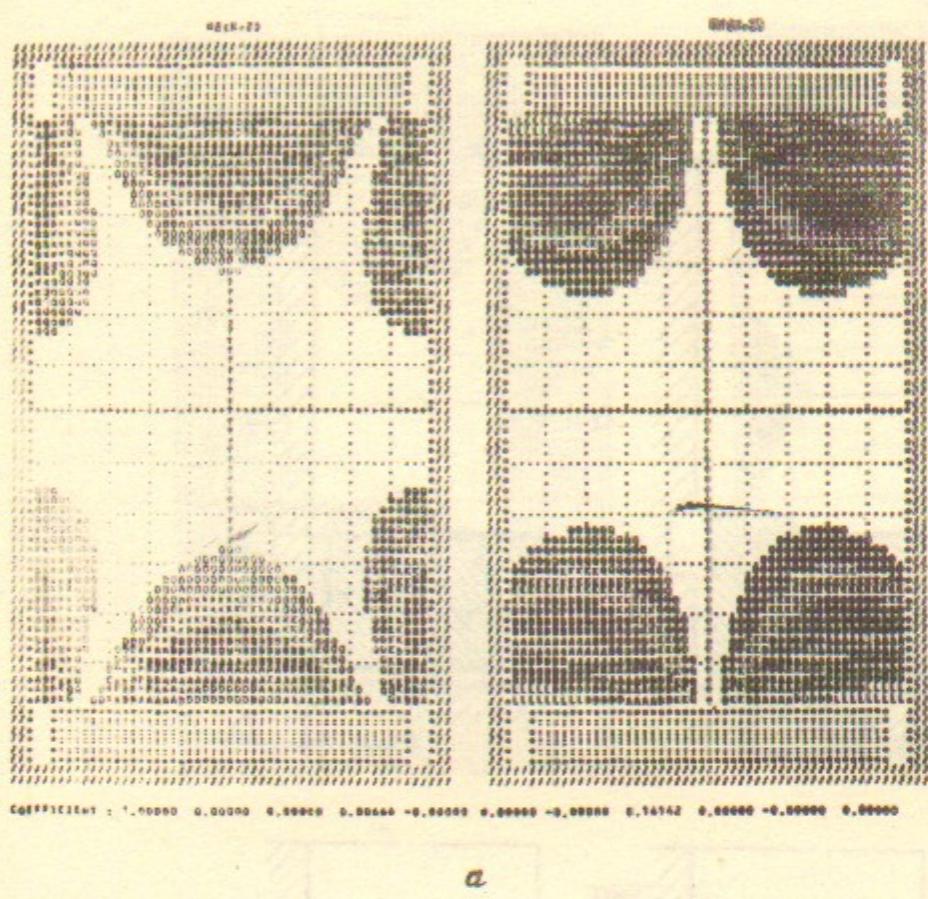
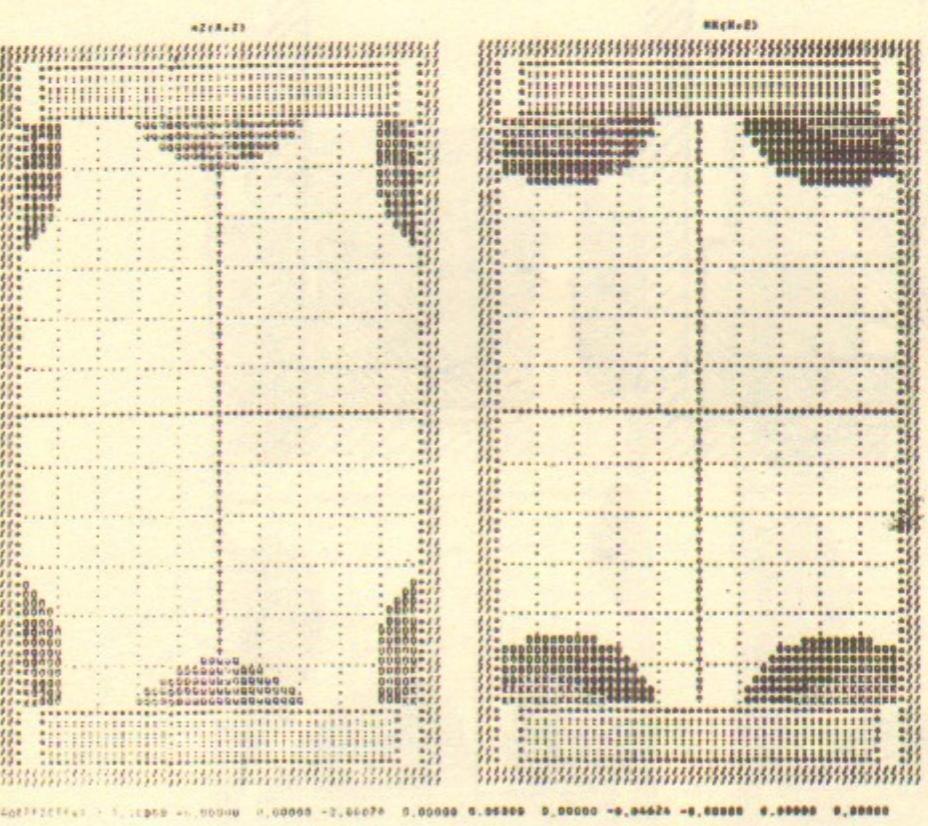


РИС. 2.



a



b

РИС. 3.

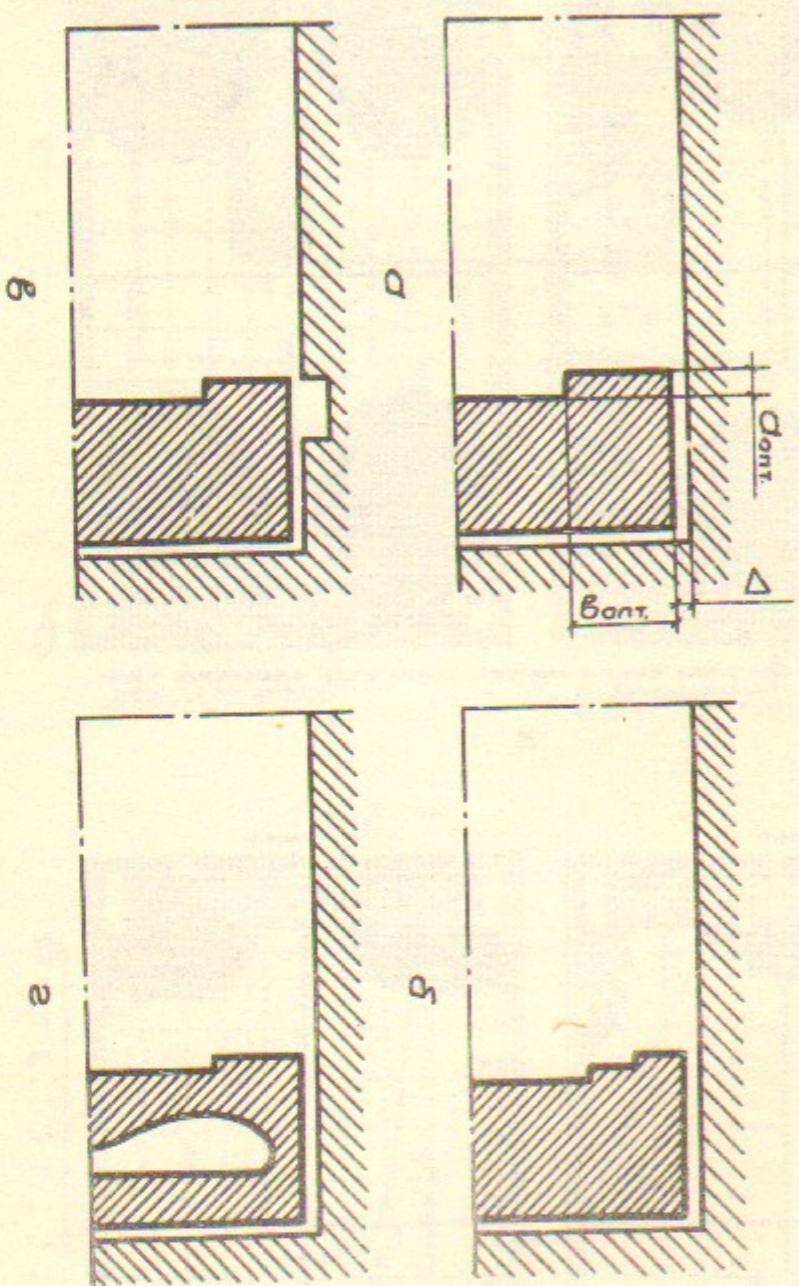


РИС. 4.

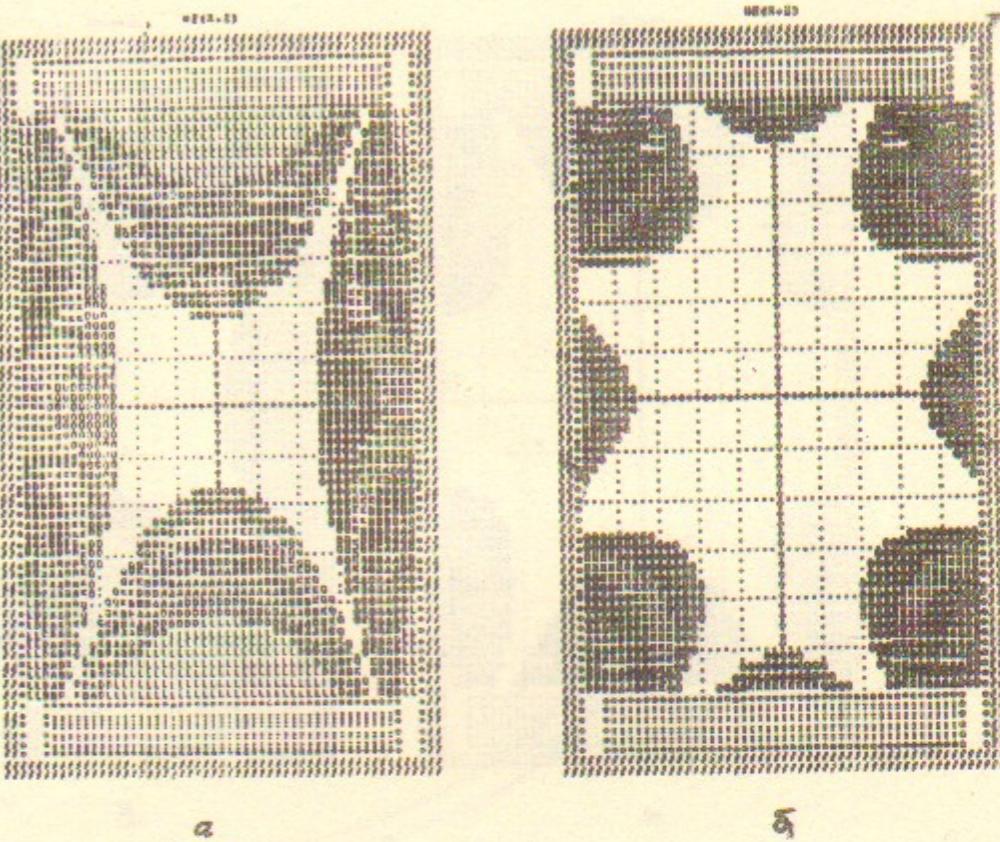


РИС. 5.

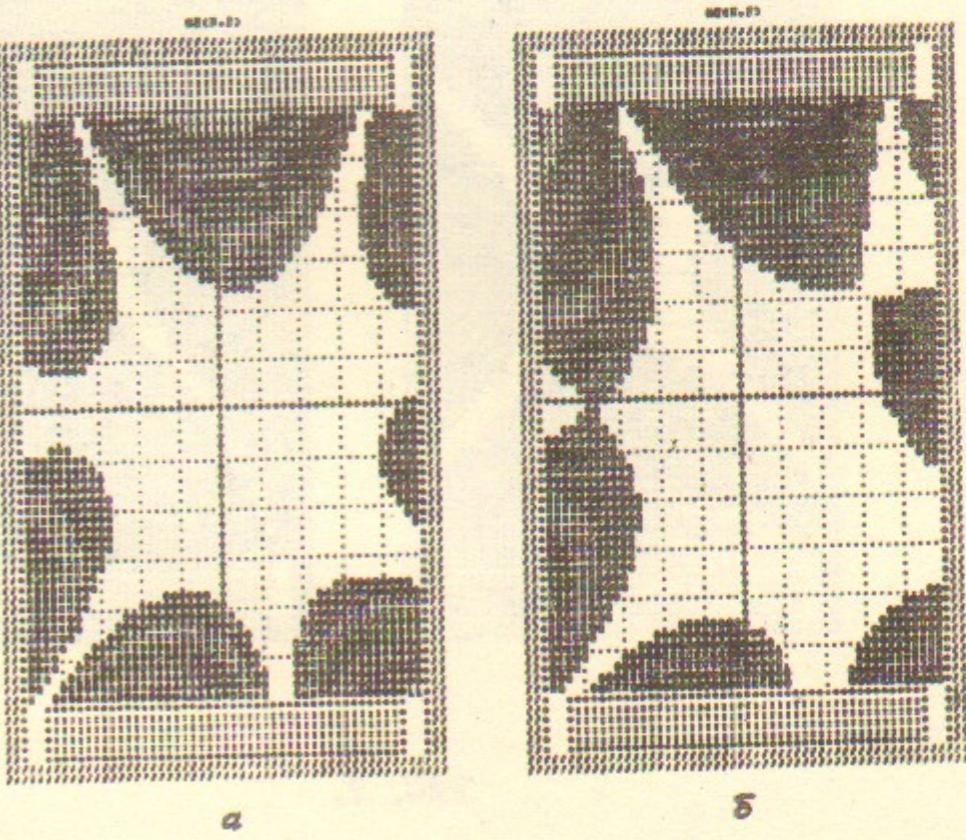


РИС. 6.

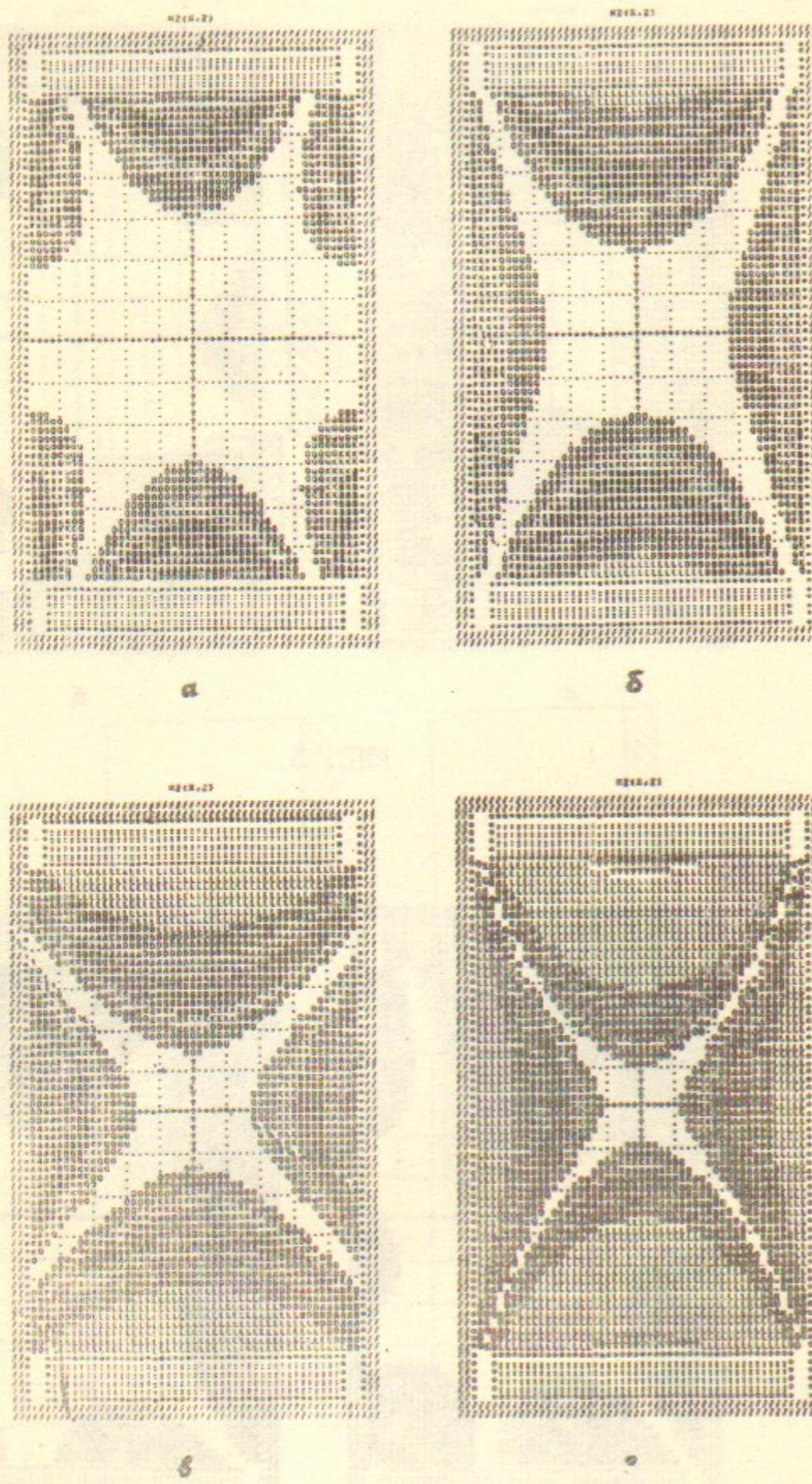


РИС. 7.

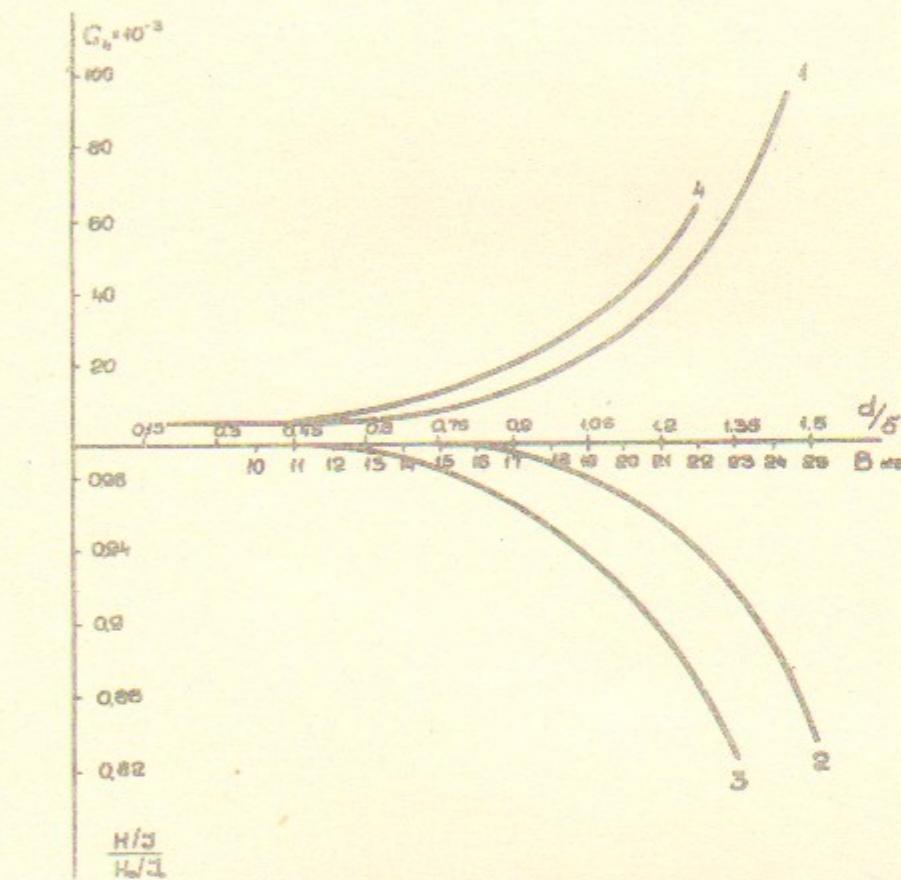


РИС. 8.